

メタル・ソース/ドレイン型Ge-CMOSのためのデバイス化技術に関する研究

永富, 雄太

<https://doi.org/10.15017/1807082>

出版情報：九州大学, 2016, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済

氏 名	永富 雄太			
論 文 名	メタル・ソース/ドレイン型 Ge-CMOS のためのデバイス化技術に関する研究			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	中島 寛
	副 査	九州大学	教授	服部 励治
	副 査	九州大学	教授	吾郷 浩樹

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、メタル・ソース/ドレイン (S/D) 型 Ge-CMOS の実現に必要となるプロセス開発において、寄生抵抗の低い S/D 形成法を確立すると共に、ゲート絶縁膜に対する Al 堆積後熱処理によってチャネル移動度が向上する機構を解明したものであり、半導体工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士 (工学) の学位論文に値するものと認める。